

Перв. примен.	ИВКМ.406222.034 (ДДТ-20КС)	Поз. обозначение	Наименование			Кол.	Примечание		
		A1	Преобразователь ИВКМ.408831.090			1			
Справ. №		R1	Терморезистор ТР-4 ОЖ0.468.254 ТУ			1			
		A2	Плата параметрического преобразователя ИВКМ.687281.230			1			
		Конденсаторы							
		C1	K10-79-250 В-0,033 мкФ ±20 %-Н30-Н АЖЯР.673511.004 ТУ			1			
		C2	K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			1			
		C3	K10-79-100 В-2,2 пФ ±0,25 пФ-МПО-Н АЖЯР.673511.004 ТУ			1			
		C4, C5	K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			2			
		C6	K10-90-1608-25 В-0,047 мкФ ±20 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			1			
		C7, C8	K10-90-1608-25 В-0,022 мкФ ±10 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			2			
		C9, C10	K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			2			
		DA1	Микросхема 544УД15У3 АЕЯР.431130.360 ТУ			1			
		DA2	Микросхема Н590КН4ВК АЕНВ.431160.636-03 ТУ			1			
		DA3	Микросхема 1432УД25БУ АЕЯР.431100.280-13 ТУ			1			
		Резисторы							
		Взам. инв. №		R1	P1-16РБ-0,063 Вт-14 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1	
R2	P1-16РБ-0,063 Вт-30,1 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1					
R3	P1-16РБ-0,063 Вт-86,6 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1					
R4	P1-16РБ-0,063 Вт-4,7 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1					
R5	P1-12-0,125-10 МОм ±5 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			1					
R6	P1-16РБ-0,063 Вт-5,9 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1					
R7	P1-12-0,062 ум.-12,1 кОм ±1 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			1					
Подп. и дата		ИВКМ.408836.112							
		Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата			
Инв. № подл.		Разраб.	Коломин			Преобразователь с электроникой	Лит.	Лист	Листов
		Пров.	Лысенко					1	7
		Нач. ОСП	Шамин						
		Н.контр.	Самсонова						
		Умв.							

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R8	P1-16PБ-0,063 Вт-12,1 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ	1	
R9	P1-16PБ-0,063 Вт-30,1 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ	1	
ZQ1	Резонатор кварцевый РК456МДУ-6ДС-10000К		
	ТУ 6321-006-07604008-04	1	
A3	Плата вычислителя ИВКМ.687281.227	1	
	Конденсаторы		
C1, C2	K53-68 "А"-25 В-1,0 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.007 ТУ	2	
C3	K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-НЗО ШУКР.673511.002 ТУ	1	
C4	K53-68 "В"-10 В-10 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.007 ТУ	1	
C5	K53-68 "А"-10 В-4,7 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.007 ТУ	1	
C6-C8	K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-НЗО ШУКР.673511.002 ТУ	3	
C9, C10	K10-79-100 В-16 пФ ±5 %-МПО-Н АЖЯР.673511.004 ТУ	2	
C11	K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-НЗО ШУКР.673511.002 ТУ	1	
DD1	Микросхема 1921BK035 АЕНВ.431290.448 ТУ	1	
	Индуктивности		
L1, L2	Чип-индуктивность КИК 1608-100 нГн ±5 % О РКМУ.671340.002 ТУ	2	
L3	Чип-индуктивность КИК 1005-3,3 нГн ±5 % О РКМУ.671340.002 ТУ	1	
	Резисторы		
R1*	C2-29BP-0,063-3,01 кОм ±0,1 %-1,0-A ШКАБ.434110.017 ТУ	1	Подбор от 200 Ом до 16,9 кОм по ряду E192
R2*	C2-29BP-0,063-9,09 кОм ±0,1 %-1,0-A ШКАБ.434110.017 ТУ	1	Подбор от 200 Ом до 16,9 кОм по ряду E192
R3	P1-16PБ-0,063 Вт-9,09 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ	1	
R4	P1-16PБ-0,063 Вт-3,01 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ	1	
R5, R6	P1-12-0,1 ум.-100 Ом ±1 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	2	
R7	P1-12-0,062 ум.-47 кОм ±5 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R8	P1-12-0,062 ум.-1 МОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
ИВКМ.408836.112			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
		Дата	

Поз. обозначение		Наименование	Кол.	Примечание
VD1		Набор диодов 2Д706АС9/ЭП АЕЯР.432120.348 ТУ	1	
ZQ1		Резонатор кварцевый РК463-6ДС-8.000 МГц-16 пФ		
		ТУ 6321-011-07604008-07	1	
A5		Плата ВИП ИВКМ.687281.186	1	
		Конденсаторы		
C1		K53-67 - 40 В - 3,3 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.006 ТУ	1	
C2		K53-67 - 32 В - 2,2 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.006 ТУ	1	
C3		K10-84В-2012М-50 В-МПО-1500 пФ ±10 %-N ФЦТА.673516.016 ТУ	1	Допуск. замена на K10-17В-50 В-МПО-1300 пФ ±10 %-2-N
				ОЖО.460.107 ТУ
C4		K10-84В-1608М-50 В-МПО-620 пФ ±10 %-N ФЦТА.673516.016 ТУ	1	Допуск. замена на K10-17В-50 В-МПО-560 пФ ±10 %-1-N
				ОЖО.460.107 ТУ
C5, C6		K53-67 - 16 В - 3,3 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.006 ТУ	2	
C7		K53-67 - 32 В - 2,2 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.006 ТУ	1	
C8		K10-84В-1608М-50 В-МПО-330 пФ ±10 %-N ФЦТА.673516.016 ТУ	1	Допуск. замена на K10-79-50 В-390 пФ ±10 %-МПО-N
				АЖЯР.673511.004 ТУ
DD1		Микросхема H564/А7В БКО.347.064 ТУ1/02	1	
		Резисторы		
R1		P1-12-0,1 ум.-20 Ом ±1 %-М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R2		P1-12-0,1 ум.-3,01 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R3		P1-12-0,1 ум.-6,8 Ом ±5 %-М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R4		P1-12-0,1 ум.-100 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R5		P1-12-0,1 ум.-3,01 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R6		P1-12-0,1 ум.-10 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R7		P1-12-0,1 ум.-1,5 кОм ±1 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R8		P1-12-0,1 ум.-100 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
R9		P1-12-0,125-6,34 кОм ±1 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	

	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	R10	P1-12-0,1 ум.-1,5 кОм ±1 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
	R11	P1-12-0,1 ум.-5,9 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
	R12	P1-12-0,1 ум.-10 Ом ±2 %-М ШКАБ.434110.002 ТУ	1	
	TV1	Трансформатор в сборе ИВКМ.671121.023	1	
	VD1	Набор диодов 2Д80ЗАС9/ЭП АЕЯР.432120.350 ТУ	1	
	VD2	Стабилитрон 2С224Ж СМЗ.362.825 ТУ	1	
	VD3	Стабилитрон 2С198Е АЕЯР.432120.376 ТУ	1	
	VD4-VD6	Набор диодов 2Д80ЗАС9/ЭП АЕЯР.432120.350 ТУ	3	
	VT1	Транзистор 2Т665А91 АЕЯР.432140.561 ТУ	1	
	VT2	Транзистор 2Т3130Б9 аА0.339.569 ТУ	1	
	VT3	Транзистор 2Т665А91 АЕЯР.432140.561 ТУ	1	

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примечание
C12		K53-68 "B"-6,3 В-22 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.007 ТУ			1	
C13		K10-79-100 В-220 пФ ±20 %-МПО-Н АЖЯР.673511.004 ТУ			1	
C14		K10-90-3216-25 В-0,39 мкФ ±20 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			1	
C15		K10-90-2012-25 В-0,15 мкФ ±20 %-Н30 ШУКР.673511.002 ТУ			1	
C16		K53-68 "B"-20 В-6,8 мкФ ±10 % АЖЯР.673546.007 ТУ			1	
DA1		Микросхема 1432УД25БУ АЕЯР.431100.280-13 ТУ			1	
DA2		Микросхема 1496УА015 АЕНВ.431130.641 ТУ			1	
DA3		Микросхема 1334ЕН3.3Т АЕЯР.431420.808 ТУ			1	
L1		Чип-индуктивность КИК 1608-100 нГн ±5 % 0 РКМУ.671340.002 ТУ			1	
L2		Чип-индуктивность КИК 2012-220 нГн ±10 % 0 РКМУ.671340.002 ТУ			1	
		Резисторы				
R1-R4		P1-12-0,062 ум.-100 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			4	
R5, R6		P1-16РБ-0,063 Вт-14 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			2	
R7, R8		P1-16РБ-0,063 Вт-3,74 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			2	
R9, R10		P1-12-0,062 ум.-10 кОм ±1 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			2	
R11		P1-12-0,062 ум.-100 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			1	
R12		P1-16РБ-0,063 Вт-30,1 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1	
R13		P1-16РБ-0,063 Вт-56,2 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1	
R14		P1-12-0,125-33 Ом ±5 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			1	
R15		P1-12-0,062 ум.-100 кОм ±2 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			1	
R16		P1-16РБ-0,063 Вт-30,1 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1	
R17		P1-16РБ-0,063 Вт-13,3 кОм ±0,5 % -Ж ШКАБ.434110.037 ТУ			1	
R18		P1-12-0,125-33 Ом ±5 % -М ШКАБ.434110.002 ТУ			1	
VD1, VD2		Набор диодов 2Д707АС9/ЭП АЕЯР.432120.349 ТУ			2	
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ИВКМ.408836.112
						Лист
						5

[illegible]

